### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

# ИССЛЕДОВАНИЕ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА. МОДЕЛЬ ЭБЕРСА-МОЛЛА

Дель работы: исследование характеристик и параметров биполярного транзистора, изучение методики измерения вольтамперных характеристик, расчет параметров модели Эберса-Молла.

## Задание и порядок выполнения работы

1. Начертить принципиальные схемы для измерения ВАХ биполярного транзистора в схеме ОЭ с указанием полярности подключения источников питания и измерительных приборов. В состав макета входят 2 биполярных транзистора: германиевый (VT1) и кремниевый (VT2). Исследуемый транзистор задается преподавателем. Выписать из приложения 3 тип и основные параметры исследуемого транзистора.

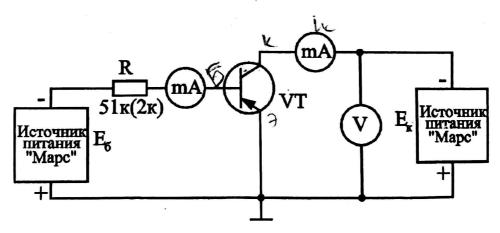


Рис. 3. Схема для исследования выходных ВАХ биполярного транзистора

2) Снять семейство выходных ВАХ транзистора в нормальном включении для трёх значений тока базы.

Собрать схему измерения в соответствии с рис. 3. В цепь базы включить резистор 51 кОм. На графике-заготовке выходной характеристики построить кривую допустимой мощности исследуемого транзистора.

Изменяя напряжение источника питания в коллекторной цепи  $E_{\kappa}$ , установить  $U_{\kappa_3}$ =- 5 В. Плавно изменяя напряжение источника питания в базовой цепи  $E_6$ , установить ток коллектора  $I_{\kappa}$ = 5 мА и измерить соответствующий ему ток базы  $I_6$ .

Снять семейство выходных характеристик транзистора при трех значениях тока базы:  $I_6$ =0,5 $I_6$ ';  $I_6$ '; 1,5 $I_6$ '. Изменяя  $E_{\kappa}$ , устанавливать по вольтметру в коллекторной цепи необходимые значения  $U_{\kappa_3}$  и измерять соответствующие значения  $I_{\kappa}$ . При измерениях следить за тем, чтобы выходные характеристики не выходили за пределы области допустимой мощности; особое внимание обратить на начальный участок ВАХ (при изменении  $U_{\kappa_3}$  от 0 до -1 В). При снятии каждой из трёх выходных ВАХ необходимо контролировать постоянство базового тока. Построить графики снятых выходных ВАХ на графике-заготовке.

Снять выходную характеристику транзистора при инверсном включении. Для этого перемычки, подходящие к коллектору и эмиттеру транзистора, поменять местами. Аналогично п. 2 определить ток базы  $I_6$ ", при котором ток коллектора равен 5 мА при напряжении на коллекторе -5 В, и снять выходную характеристику при токе базы  $I_6$ ".

Определить статический коэффициент передачи тока базы для нормального и инверсного включений транзистора для точки с напряжени-

ем на коллекторе -5 В и токов базы соответственно  $I_6$  и  $I_6$ ".

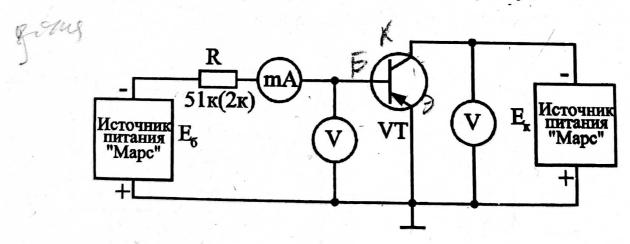


Рис. 4. Схемы для исследования входной ВАХ биполярного транзистора

5. Снять входные характеристики транзистора при нормальном включении.

Собрать схему в соответствии с рис. 4. Установить  $U_{\kappa_3}$ =- 5 В. Изменяя  $E_6$ , устанавливать по миллиамперметру в базовой цепи необходимые значения  $I_6$  и измерять соответствующие значения  $U_{69}$ . Ток базы изменять от 0

до  $1,5I_6$ ', шаг изменения выбрать таким, чтобы получить в указанном диапазоне не менее 8 точек.

Аналогично снять входную характеристику при напряжении на коллекторе 0 В (для этого необходимо уменьшить напряжение источника коллекторного питания до нуля и после этого соединить коллектор с эмиттером (т.е. с общим проводом).

Снять входную характеристику транзистора при инверсном

включении при  $U_{\kappa_3}$ =-5 В. Ток базы изменять от 0 до 1,5  $I_6$ ".

# Обработка экспериментальных данных

- 1. По снятым ВАХ графически определить h-параметры для  $I_{\kappa} = 5$ мА и  $U_{K} = -5 B$ .
- 2. Использовать результаты измерений в прямом и инверсном включении для определения параметров модели Эберса-Молла (для РЛ-1).

# Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- 1) название и цель работы;
- 2) схемы проведения измерений с указанием типов измерительных приборов;
- 3) параметры исследованного биполярного транзистора;
- 4) графики измеренных ВАХ;
- 5) результаты обработки экспериментальных данных;
- выводы по результатам работы.



#### МП42, МП42А, МП42Б

Транзисторы германиевые сплавные p-n-p переключательные низкочастотные маломощные. Предназначены для применения в схемах переключения. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:

 $M\Pi 42 - 20 - 35$ ,

 $M\Pi 42A - 30 - 50,$ 

 $M\Pi 42F - 45 - 100.$ 

Обратный ток коллектора при  $U_{\kappa_3}$ =15 В – не более 25 мкА.

Предельная частота коэффициента передачи тока при  $U_{\kappa 6}$ =5 B – не менее 1 МГц.

Емкость коллекторного перехода при  $U_{\kappa 6}$ =5 В – не более 60 п $\Phi$ .

Предельное постоянное напряжение коллектор-эмиттер – 15 В.

Предельное постоянное напряжение эмиттер-база -10 B.

Предельный импульсный ток коллектора – 200 мА.

Предельная постоянная рассеиваемая мощность – 200 мВт.

## КТ203Б, КТ 203БМ

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные p-n-p усилительные маломощные. Предназначены для применения в усилителях и импульсных устройствах. Выпускаются в металлостеклянном (КТ203Б) и пластмассовом (КТ203БМ) корпусе с гибкими выводами.

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала – 30 – 150.

Обратный ток коллектора при  $U_{\kappa 6}$ =5 В – не более 1 мкА.

Предельная частота коэффициента передачи тока в схеме ОБ при  $U_{\kappa 6}$ =5 В – не менее 5 МГц.

Емкость коллекторного перехода при  $U_{\kappa 6}$ =5 В – не более 10 п $\Phi$ .

Предельное постоянное напряжение коллектор-эмиттер – 30 В.

Предельное постоянное напряжение эмиттер-база – 15 В.

Предельный постоянный ток коллектора – 10 мА.

Предельная постоянная рассеиваемая мощность – 150 мВт.

#### KT501M

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные p-n-p усилительные низкочастотные маломощные. Предназначены для применения в усилителях и импульсных устройствах. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ – 40 – 120.

Обратный ток коллектора при  $U_{\kappa 6}$ =5 В – не более 1 мкА.